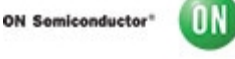


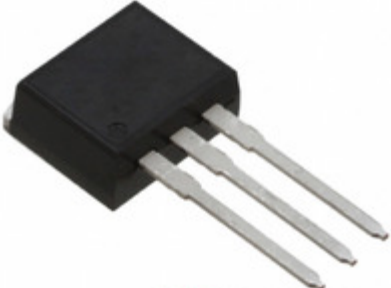


| | |
|--|---|
|   | <h2 style="color: red;">FQI4N25TU</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQI4N25TU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQI4N25TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FQI4N25TU |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | I2PAK |
| Serie | QFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.75 Ohm @ 1.8A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.13W (Ta), 52W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 200pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 5.6nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 250V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.6A (Tc) |

FQI4N25TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI4N25TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI4N25TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQI4N25TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>FQI4N20TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A I2PAK</p> |  <p>FQI4N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK</p> |  <p>FQI4N60 Original FQI4N60 Original</p> |  <p>FQI4N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK</p> |
|  <p>FQI4N20LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A I2PAK</p> |  <p>FQI4N20LTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A I2PAK</p> |  <p>FQI4N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK</p> |  <p>FQI4N80 FAIRCHI FQI4N80 FAIRCHI</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| FQI4N25TU Fairchild/ON Semiconductor | FQI4N25TU Datenblatt | FQI4N25TU-Datenblätter | FQI4N25TU PDF | Fairchild/ON Semiconductor FQI4N25TU |
| FQI4N25TU Electronic | FQI4N25TU-Komponenten | FQI4N25TU-Verteiler | FQI4N25TU-Bild | FQI4N25TU-Teil |
| FQI4N25TU Preis | FQI4N25TU Hersteller | FQI4N25TU Bild | FQI4N25TU Aktie | FQI4N25TU Inventar |
| FQI4N25TU Neu | FQI4N25TU Original | FQI4N25TU garantiert | FQI4N25TU RFQ | FQI4N25TU Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited